



13009 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）

芯片代码：D423AG-00

芯片厚度：240±20μm

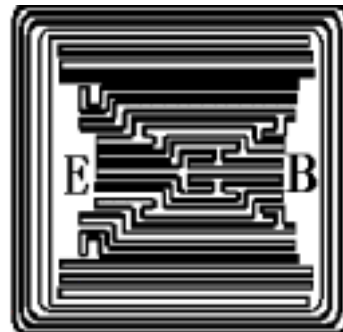
管芯尺寸：4230×4230μm²焊位尺寸：B 极 1200×420μm²，E 极 1140×540μm²

电极金属：铝

背面金属：银

典型封装：KSE13009，HE13009

管芯示意图

极限值（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

T _{stg}	贮存温度	-65~150
T _j	结温	150
P _C	集电极耗散功率（T _c =25℃）	100W
V _{CBO}	集电极—基极电压	700V
V _{CEO}	集电极—发射极电压	400V
V _{EBO}	发射极—基极电压	9V
I _C	集电极电流（DC）	16A
I _B	基极电流	6A

电参数（T_a=25℃）（封装形式：TO-220）

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	400			V	I _C =10mA，I _B =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			1	mA	V _{EB} =9V，I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V，I _C =5A
		6		30		V _{CE} =5V，I _C =8A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			1	V	I _C =5A，I _B =1A
				1.5	V	I _C =8A，I _B =1.6A
				3	V	I _C =12A，I _B =3A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1.2	V	I _C =5A，I _B =1A
				1.6	V	I _C =8A，I _B =1.6A
C _{ob}	共基极输出电容		180		pF	V _{CB} =10V，f=0.1MHz
f _T	特征频率	4			MHz	V _{CE} =10V，I _C =0.5A
t _{ON}	导通时间			1.1	μs	V _{CC} =125V，I _C =8A I _{B1} =-I _{B2} =1.6A
t _{STG}	贮存时间			3.0	μs	
t _F	下降时间			0.7	μs	